

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

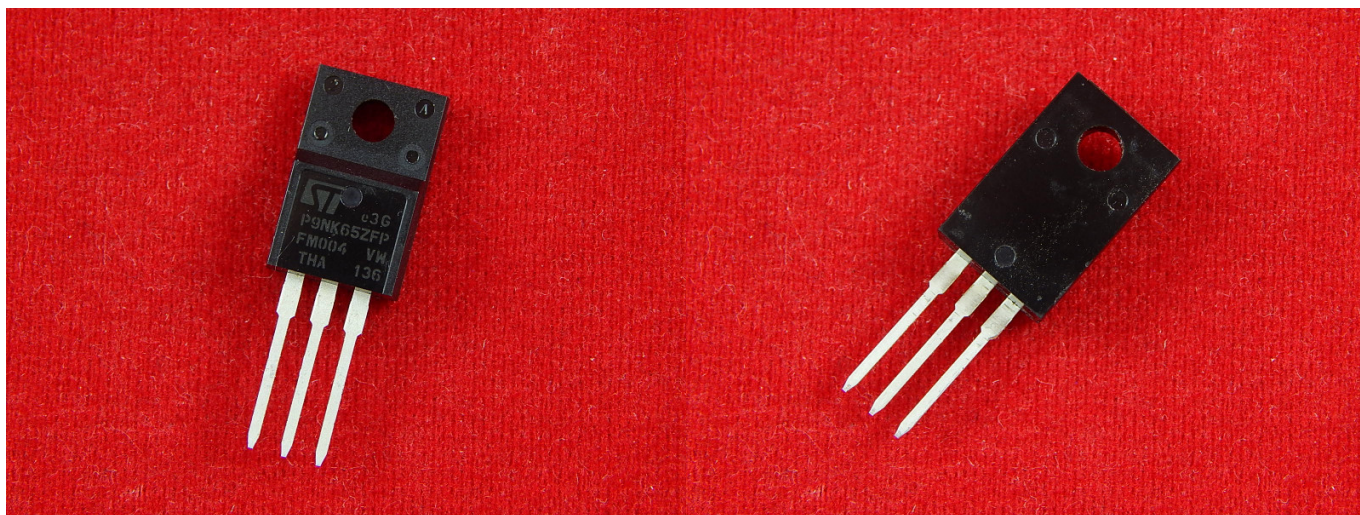
E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16297

Цена в прайсе: 749 тг.

Транзистор STP9NK65ZFP, МОП-структура, N-канал, 650В, 6.4А, ТО-220-3



МОП-структура — полупроводниковая структура, применяемая при производстве микросхем и дискретных полевых транзисторов. Полупроводниковые приборы на основе этой структуры называют МОП-транзисторами, МДП-транзисторами или транзисторами с изолированным затвором.

Это устройство представляет собой N-канальный МОП-транзистор с защитой от зенера, разработанный с использованием технологии SuperMESH™ от STMicroelectronics, достигнутый за счет оптимизации хорошо зарекомендовавшей себя компоновки PowerMESH™ на основе полос ST. В дополнение к значительному снижению сопротивления включению, это устройство предназначено для обеспечения высокого уровня возможностей dv/dt для самых требовательных приложений.

Спецификация:

- Модель: STP9NK65ZFP;
- Полярность транзистора: N-Channel;
- Количество каналов: 1 Channel;
- Напряжение пробоя сток-исток: 650V;
- Непрерывный ток утечки: 6.4A;
- Сопротивление сток-исток: 1.2Ohms;
- Напряжение затвор-исток: от -30V до + 30V;
- Пороговое напряжение затвор-исток: 3.75V;
- Заряд затвора: 41 нс;
- Рассеивание мощности: 30W;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C;

- Корпус: ТО-220-3.

Схема:

